

	<h2 style="color: red;">FQD12P10TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD12P10TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD12P10TF.pdf 2.FQD12P10TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7555 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD12P10TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7555 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 9.4A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 4.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD12P10TF ist neu im Original, Suche FQD12P10TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12P10TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD12N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12P10 FAIRCHI FQD12P10 FAIRCHI</p>	 <p>FQD12N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>
 <p>FQD13N06 FAIRCHI FQD13N06 FAIRCHI</p>	 <p>FQD12P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20LTF	↔ FQD10N20LTM	⇒ FQD10N20LTM	D FQD10N20TF	⇒ FQD10N20TF
⊕ FQD10N20TM	⊗ FQD10N20TM	D FQD11P06	⇒ FQD11P06-NL	⇒ FQD11P06TF
⊗ FQD11P06TF	⊕ FQD11P06TM	⊗ FQD11P06TM	↔ FQD12N10	⇒ FQD12N20
D FQD12N20L	⊗ FQD12N20LTF	⊕ FQD12N20LTF	⊗ FQD12N20LTM	⇒ FQD12N20LTM
⇒ FQD12N20TF	↔ FQD12N20TF	⊗ FQD12N20TM	⊕ FQD12N20TM	⇒ FQD12P10
↔ FQD12P10TF	⇒ FQD12P10TM	D FQD12P10TM	⊗ FQD13N06	⊕ FQD13N06L
⊗ FQD13N06LTF	D FQD13N06LTF	⇒ FQD13N06LTM	↔ FQD13N06LTM	⇒ FQD13N06LTM-NL
⊕ FQD13N06TF	⊗ FQD13N06TF	↔ FQD13N06TM	⇒ FQD13N06TM	⇒ FQD13N10
⊗ FQD13N10L	⊕ FQD13N10LTF	⊗ FQD13N10LTF	D FQD13N10LTM	⇒ FQD13N10LTM
↔ FQD13N10LTM-NL	⊗ FQD13N10TM	⊕ FQD13N10TM	⊗ FQD13N20D	⇒ FQD14N15

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited